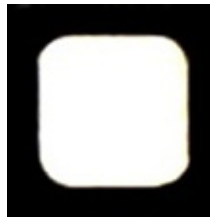


Silicon Carbide Power Schottky Diode Chip

Features

- 1200 V Schottky rectifier
- 250 °C maximum operating temperature
- Temperature independent switching behavior
- Superior surge current capability
- Positive temperature coefficient of V_F
- Extremely fast switching speeds
- Superior figure of merit Q_C/I_F



Maximum Ratings at $T_J = 250\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Values	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1200	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 215\text{ °C}$	5	A
RMS forward current	$I_{F(RMS)}$	$T_C \leq 215\text{ °C}$	8	A
Operating and storage temperature	T_J, T_{stg}		-55 to 250	°C

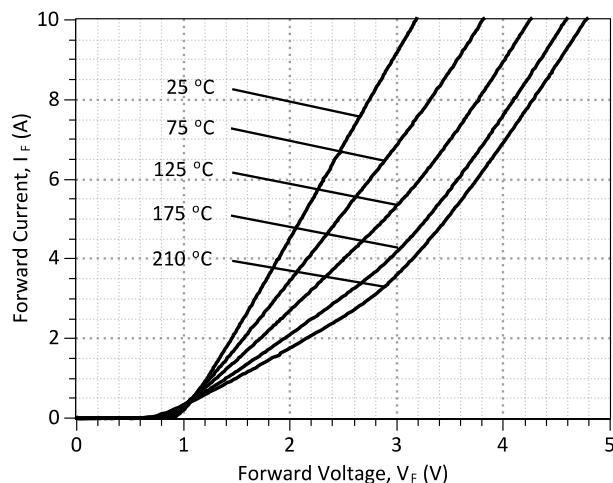
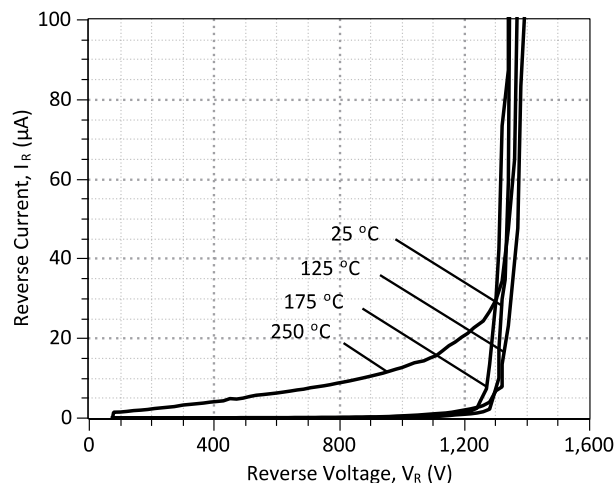
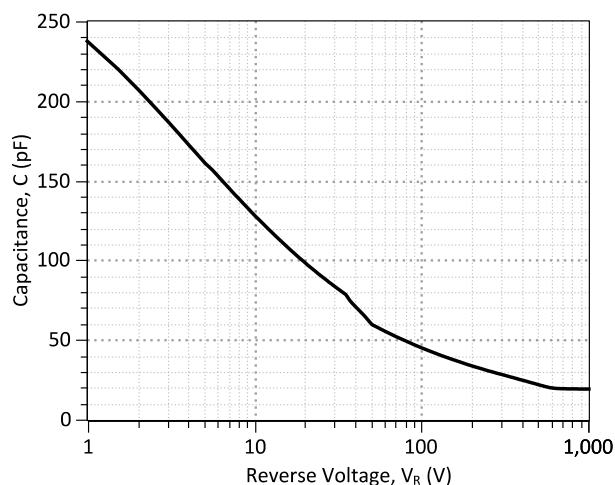
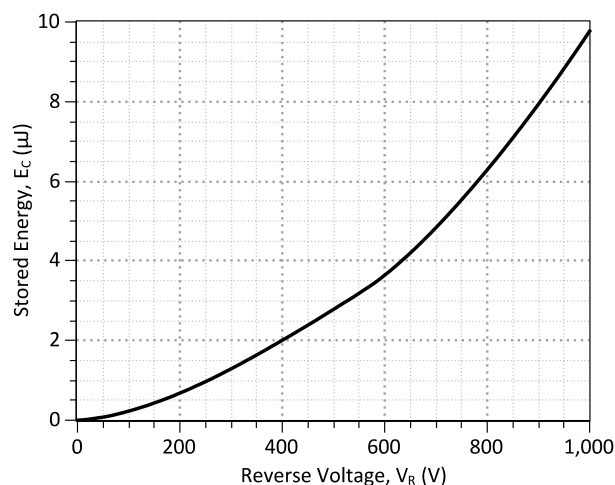
Electrical Characteristics at $T_J = 250\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 5\text{ A}, T_J = 25\text{ °C}$		2.1		V
		$I_F = 5\text{ A}, T_J = 210\text{ °C}$		3.5		
Reverse current	I_R	$V_R = 1200\text{ V}, T_J = 25\text{ °C}$		0.9	10	μA
		$V_R = 1200\text{ V}, T_J = 250\text{ °C}$		20.8	150	
Total capacitive charge	Q_C	$I_F \leq I_{F,MAX}$ $dI_F/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$ $T_J = 210\text{ °C}$	$V_R = 400\text{ V}$	17		nC
			$V_R = 960\text{ V}$	29		
Switching time	t_s		$V_R = 400\text{ V}$	< 25		ns
			$V_R = 960\text{ V}$			
Total capacitance	C	$V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, T_J = 25\text{ °C}$		237		pF
		$V_R = 400\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, T_J = 25\text{ °C}$		25		
		$V_R = 1000\text{ V}, f = 1\text{ MHz}, T_J = 25\text{ °C}$		20		

Thermal Characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	Assuming TO-276 package	1.38	°C/W
-------------------------------------	------------	-------------------------	------	------

*For chip size and metallization, please refer to the mechanical datasheet (must have a non-disclosure agreement with GeneSiC Semiconductor).


Figure 1: Typical Forward Characteristics

Figure 2: Typical Reverse Characteristics

Figure 3: Typical Junction Capacitance vs Reverse Voltage Characteristics

Figure 4: Typical Switching Energy vs Reverse Voltage Characteristics

Revision History

Date	Revision	Comments	Supersedes
2012/04/03	0	Initial release	

Published by
 GeneSiC Semiconductor, Inc.
 43670 Trade Center Place Suite 155
 Dulles, VA 20166

GeneSiC Semiconductor, Inc. reserves right to make changes to the product specifications and data in this document without notice.

GeneSiC disclaims all and any warranty and liability arising out of use or application of any product. No license, express or implied to any intellectual property rights is granted by this document.

Unless otherwise expressly indicated, GeneSiC products are not designed, tested or authorized for use in life-saving, medical, aircraft navigation, communication, air traffic control and weapons systems, nor in applications where their failure may result in death, personal injury and/or property damage.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[GB05SHT12-CAL](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9